
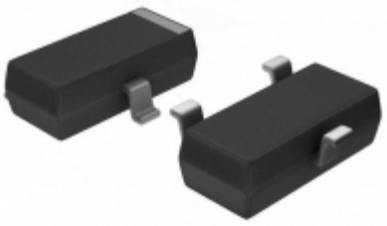
	<p>SI2392DS-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI2392DS-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 3.1A SOT-23</p> <p>Datenblätter:  SI2392DS-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 66816 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI2392DS-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 3.1A SOT-23
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	66816 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 3.1A (Tc) 1.25W (Ta), 2.5W (Tc)
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23
Verlustleistung (max)	1.25W (Ta), 2.5W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.1A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	126 mOhm @ 2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10.4nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	196pF @ 50V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI2392DS-T1-GE3TR

SI2392DS-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI2392DS-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI2392DS-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI2392DS-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI2392ADS-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 3.1A SOT-23</p>	 <p>SI2392ADS-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 100V 3.1A SOT-23</p>	 <p>SI2399 SIPU SI2399 SIPU</p>	 <p>SI2392DS-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 100V 3.1A SOT-23</p>
 <p>SI2399DS-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 6A SOT-23</p>	 <p>SI2392ADS-T1-E3 VISHAY SI2392ADS-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI2399DS-T1-E3 Son SI2399DS-T1-E3 Son</p>	 <p>SI2392DS-T1-E3 AOS SI2392DS-T1-E3 AOS</p>

heiße Teile

Mehr

SI2365EDS-T1-GE3	SI2366DS-T1-E3	SI2366DS-T1-GE	SI2366DS-T1-GE3	SI2366DS-T1-GE3
SI2367DS-T1-E3	SI2367DS-T1-GE3	SI2367DS-T1-GE3	SI2369DS-T1-GE3	SI2369DS-T1-GE3
SI2371EDS-T1-GE3	SI2371EDS-T1-GE3	SI2372DS-T1-E3	SI2372DS-T1-GE3	SI2372DS-T1-GE3
SI2374DS-T1-GE3	SI2374DS-T1-GE3	SI2377DS-T1-GE3	SI2377EDS	SI2377EDS-T1-E3
SI2377EDS-T1-GE3	SI2377EDS-T1-GE3	SI2392ADS-T1-E3	SI2392ADS-T1-GE3	SI2392ADS-T1-GE3
SI2392DS-T1-GE3	SI2399CDS-T1-GE3	SI2399DS-T1-GE3	SI2399DS-T1-GE3	SI2400-B5
SI2400-FS	SI2400-FSR	SI2400-KS	SI2400-KSR	SI2401-FS
SI2401-FSR	SI2401-FSR.	SI2401-KS	SI2403-FTR	SI2404-C-FSR
SI2404-C-FTR	SI2404-C-ZSR	SI2404-CFTRP	SI2404-FS	SI2404-FT
SI2413AP	SI2414-F-FTR	SI2414-FT	SI2414-FTR	SI2414-KT

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited